

EMC最適化設計、高速CANトランシーバ

特長

- 車載アプリケーションに対応
- ISO 11898-2/-5以上の要件に適合
- GIFT/ICT準拠
- バス端子上的ESD保護：最大±12kV (HBM)
- バス・ウェイクアップ付き低電流スタンバイ・モード、最大12μA
- 高い電磁環境適合性 (EMC)
- SPLIT電圧源を使用した分割終端によるバス同相モード安定化
- 3.3Vおよび5Vマイクロプロセッサに対応したデジタル入力
- 保護機能
 - -27V~40Vのバス障害保護
 - TXDドミナント・タイムアウト
 - 過熱保護
 - パワーアップ/ダウン時のグリッチフリー・バス入出力
 - 低VCC時の高いバス入力インピーダンス (非通電時にバス上で理想的なパッシブ動作)

アプリケーション

- GMW3122デュアル・ワイヤCAN物理層
- SAE J2284車載アプリケーション用高速CAN
- SAE J1939標準データ・バス・インターフェイス
- ISO 11783標準データ・バス・インターフェイス

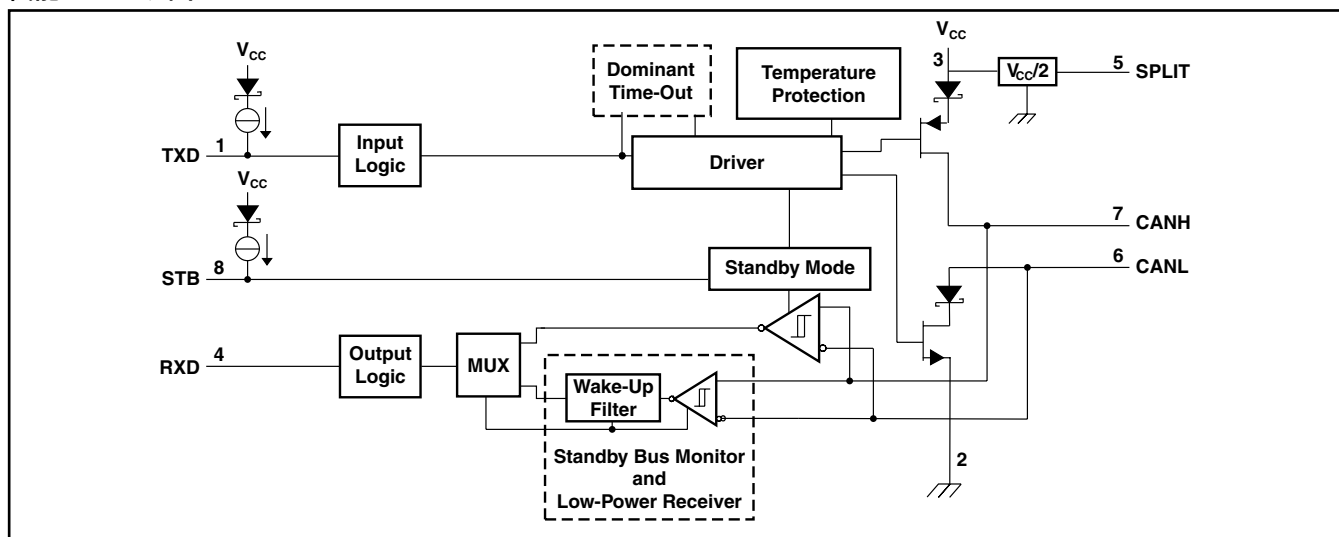
概要

SN65HVDA1040Aは、CAN (Controller Area Network) に対応したアプリケーションで使用するためのISO 11898標準に準拠し、車載アプリケーション向けに開発されています。CANトランシーバとして、バスへの差動送信機能とCANコントローラへの差動受信機能を、最大1メガビット/秒 (Mbps) ⁽¹⁾の信号レートで実現します。

SN65HVDA1040Aは、特に厳しい環境での動作を想定して設計され、低電圧ロックアウト、過熱シャットダウン、広い同相

(1) ラインの信号レートは、1秒あたりの電圧の遷移数をbps (ビット/秒) 単位で表したものです。

機能ブロック図



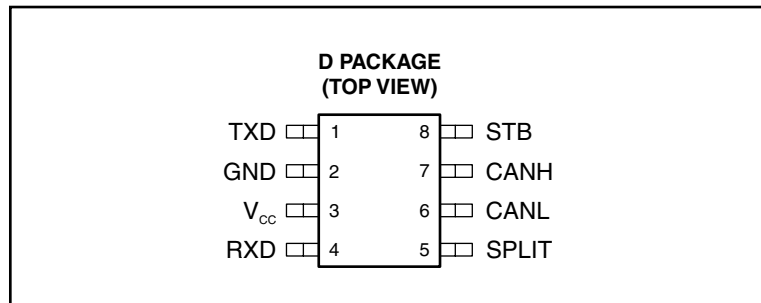
この資料は、Texas Instruments Incorporated (TI) が英文で記述した資料を、皆様のご理解の一助として頂くために日本テキサス・インスツルメンツ (日本TI) が英文から和文へ翻訳して作成したものです。資料によっては正規英語版資料の更新に対応していないものがあります。日本TIによる和文資料は、あくまでもTI正規英語版をご理解頂くための補助的参考資料としてご使用下さい。製品のご検討およびご採用にあたりましては必ず正規英語版の最新資料をご確認下さい。TIおよび日本TIは、正規英語版にて更新の情報を提供しているにもかかわらず、更新以前の情報に基づいて発生した問題や障害等につきましては如何なる責任も負いません。

モード範囲、グラウンド保護喪失など、多くのデバイス保護機能を搭載しています。また、バス・ピンは、外部クロスワイヤ、-27V~40Vへの短絡、およびISO7637に従った過渡電圧に対しても保護されています。



静電気放電対策

これらのデバイスは、限定的なESD(静電破壊)保護機能を内蔵しています。保存時または取り扱い時に、MOSゲートに対する静電破壊を防止するために、リード線どうしを短絡しておくか、デバイスを導電性のフォームに入れる必要があります。



端子機能

端子		種類	説明
名前	番号		
TXD	1	I	CAN送信データ入力(バスがドミナント状態のときは“Low”、リセッピ状態のときは“High”)
GND	2	GND	グラウンド接続
VCC	3	電源	トランシーバの5V電源電圧入力
RXD	4	O	CAN受信データ出力(バスがドミナント状態のときは“Low”、リセッピ状態のときは“High”)
SPLIT	5	O	同相モード安定化出力
CANL	6	I/O	“Low” レベルCANバス・ライン
CANH	7	I/O	“High” レベルCANバス・ライン
STB	8	I	スタンバイ・モード選択ピン(アクティブ・ハイ)

製品情報⁽¹⁾

T _A	パッケージ ⁽²⁾		オーダー可能な部品番号	上面の捺印
-40°C ~ 125°C	SOIC - D	2500個(1リール)	SN65HVDA1040AQRQ1	A1040A

(1) 最新のパッケージおよびご注文情報については、このドキュメントの巻末にある「付録：パッケージ・オプション」を参照するか、TIのWebサイト(www.ti.comまたはwww.tij.co.jp)をご覧ください。

(2) パッケージ図面、熱特性データ、記号の意味については、www.ti.com/packagingを参照してください。

機能説明

動作モード

STBピン	モード	ドライバ	レシーバ	RXDピン
LOW	通常	イネーブル	イネーブル	CANバスをミラーリング
HIGH	スタンバイ	ディスエーブル (オフ)	低電力ウェークアップ・レシーバおよびバス・モニタがイネーブル	Low: ウェークアップ要求を受信時 High: ウェークアップ要求を非受信時

表 1. 動作モード

このデバイスには、通常モードとスタンバイ・モードという2つの主要な動作モードがあります。動作モードは、STB入力ピンを使用して選択します。

通常モード

これは、デバイスの通常時の動作モードです。このモードは、STBを“Low”にすることで選択されます。CANドライバおよびレシーバは完全に動作可能で、CAN通信が双方向で行われます。ドライバはTXD上のデジタル入力をCANHおよびCANL上の差動出力へと変換します。レシーバはCANHおよびCANL上の差動信号をRXD上のデジタル出力へと変換します。リセッパ状態では、バス・ピンは $0.5 \times V_{CC}$ にバイアスされます。ドミナント状態では、バス・ピン (CANHおよびCANL) は差動で駆動されます。論理“High”はバス上のリセッパ信号に等価で、論理“Low”はバス上のドミナント(差動)信号に等価です。

分割終端ネットワーク・アプリケーションでは、バス同相モードのバス電圧バイアス安定化のために、SPLITピンが $0.5 \times V_{CC}$ にバイアスされます。

スタンバイ・モードおよびRXDウェークアップ要求

これは、デバイスの低電力モードです。このモードは、STBを“High”にすることで選択されます。CANドライバとメイン・レシーバがオフになり、双方向のCAN通信は実行できません。低電力レシーバとバス・モニタはイネーブルであり、バス経由でウェークアップ要求を受け付けることができます。ウェークアップ要求は、フィルタ時間 t_{BUS} よりも長いドミナント・バス送信に対して、RXDに出力(“Low”に駆動)されます。ローカルのプロトコル制御回路(MCU)では、RXDの遷移を監視し、ウェークアップ要求に基づいてデバイスを通常モードに復帰させる必要があります。CANバス・ピンはGNDにウィーク・プルダウンされ、SPLITピンはオフ(フローティング)になります。

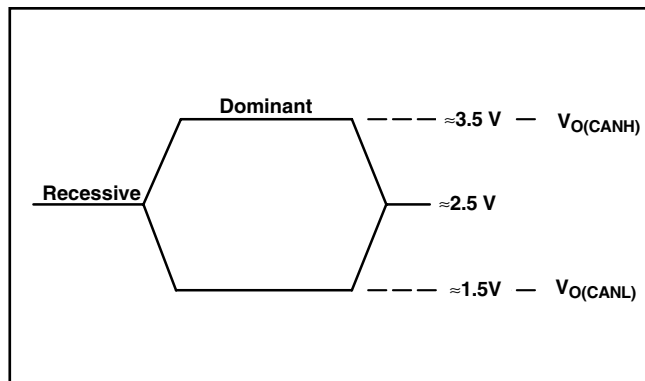


図 1. バスの論理状態電圧の定義

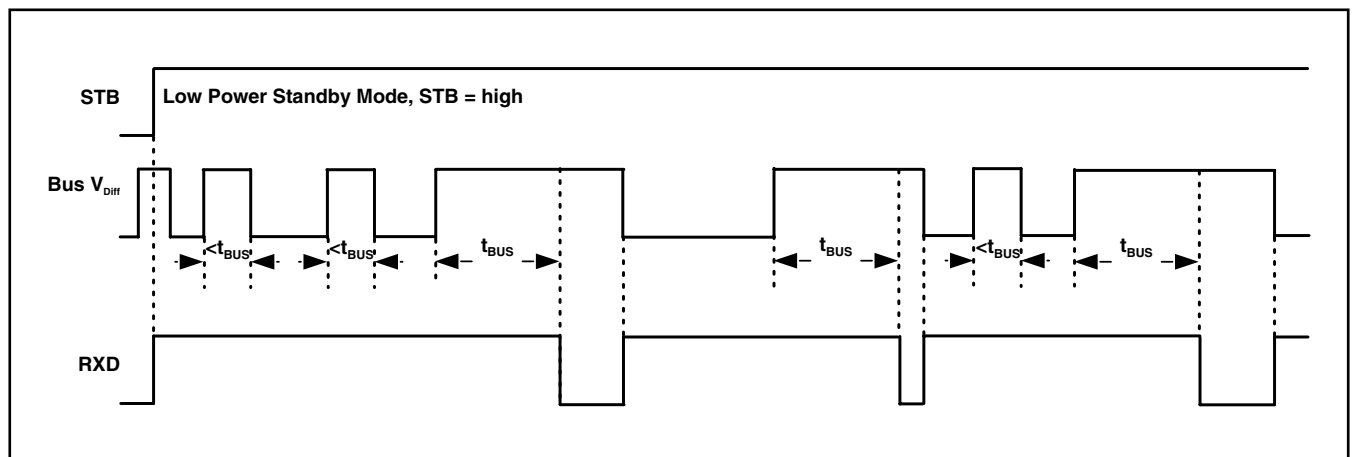


図 2. スタンバイ・モードでの低電力レシーバとバス・モニタの動作

ドライバおよびレシーバの機能表

入力		出力		バス状態
TXD	STB	CANH	CANL	
L	L	H	L	ドミナント
H	L	Z	Z	リセッピブ
オープン	L	Z	Z	リセッピブ
X	Hまたはオープン	Y	Y	リセッピブ

表 2. ドライバ機能表⁽¹⁾

(1) H = “High” レベル、L = “Low” レベル、X = 無関係、
Y = GNDにウィーク・プルダウン、? = 不定、
Z = ハイ・インピーダンス

差動入力 $V_{ID} = V(CANH) - V(CANL)$	STB	出力 RXD	バス状態
$V_{ID} \geq 0.9\text{ V}$	L	L	ドミナント
$V_{ID} \geq 1.15\text{ V}$	Hまたはオープン	L	ドミナント
$0.5\text{ V} < V_{ID} < 0.9\text{ V}$	X	?	?
$V_{ID} \leq 0.5\text{ V}$	X	H	リセッピブ
オープン	X	H	リセッピブ

表 3. レシーバ機能表

保護機能

TXDドミナント状態タイムアウト

通常モード (CANドライバがアクティブな唯一のモード) 時には、TXDドミナント・タイムアウト回路により、ハードウェアまたはソフトウェア障害の発生時に、TXDがタイムアウト時間 t_{DST} よりも長くドミナントに保持されないようにして、トランシーバがネットワーク通信をブロックすることを防止します。ドミナント・タイムアウト回路は、TXDの立ち下がりエッジでトリガされます。回路のタイムアウト定数 (t_{DST}) に達する前に立ち上がりエッジが検出されない場合、CANバス・ドライバがディスエーブルになり、バスが他のネットワーク・ノード間の通信用に解放されます。TXDピンにリセッピブ信号が検出されるとCANドライバが再びアクティブになり、ドミナント状態タイムアウトがクリアされます。TXDドミナント状態タイムアウトの間、CANバス・ピンはリセッピブ・レベルにバイアスされ、SPLITはオンに保持されます。

使用上の注意： TXDドミナント状態タイムアウトで許可される最大のTXDドミナント時間によって、デバイスの可能な最小データ・レートが制限されます。CANプロトコルでは、ワーストケースで最大11の連続したドミナント・ビット (TXD上) が許可されています。これは、5個の連続したドミナント・ビットの直後にエラー・フレームが続く場合です。これに加えて、 $t_{(dom)}$ の最小値によって、最小ビット・レートが制限されます。最小ビット・レートは次のように計算できます。

$$\text{最小ビット・レート} = 11/t_{(dom)}$$

過熱シャットダウン

デバイスの接合部温度が過熱シャットダウン・スレッショルドを超えた場合、CANドライバ回路がSPLITピンも含めてオフになります。この状態は、温度がデバイスの過熱シャットダウン温度を下回るとクリアされます。

低電圧ロックアウト/非通電デバイス

このデバイスには、 V_{CC} 電源の低電圧検出およびロックアウト機能があります。 V_{CC} に低電圧状態が検出された場合、デバイスはバスを保護します。

TXDピンは V_{CC} にプルアップされ、ピンがフローティングになると強制的にリセッピブ入力レベルになります。STBピンは V_{CC} にプルアップされ、ピンがフローティングになると強制的にデバイスがスタンバイ・モード (低電力) になります。

すべてのバス・ピン (CANH、CANL、およびSPLIT) は、デバイスが非通電状態になるとリーク電流が極めて低くなるため、バスに大きな負荷を与えず、バスに対して “理想的なパッシブ” 負荷となります。これは、ネットワークの一部のノードが非通電で残りは動作中であるような場合に、特に重要です

アプリケーションのヒント

3.3Vマイクロコントローラとの使用

このデバイスのデジタル入力ピンの入力レベル・スレッショルドは3.3V互換ですが、このデバイスを3.3Vマイクロコントローラとともに使用する場合は、アプリケーションでいくつかの点に注意する必要があります。TXDおよびSTB入力ピンは、ともに内部で V_{CC} にプルアップされています。この場合、一部のマイクロコントローラ・メーカーでは、プルアップによって電流が制限されるものの、I/Oピン上にオープン・ドレイン構成を使用することを推奨しています。そのため、アプリケーション・レベルで、TXDおよびSTBのプルアップがCANのシステム・タイミング要件を満足するのに十分なレベルとなるよう配慮する必要があります。特に、TXDの内部プルアップは、寄生容量の影響下で適切なCANタイミングを実現するには不十分な場合があります。追加の外部プルアップを要する場合があります。このデバイスのRXD出力は V_{CC} 範囲全体(5V)を駆動するため、マイクロコントローラのRXDピンについても注意が必要です。マイクロコントローラのRXD入力ピンが5Vトレラントでない場合は、アプリケーション・レベルでの対処が必要となります。他のオプションとしては、Texas InstrumentsのI/Oレベル適応型CANトランシーバ、または3.3V CANトランシーバを使用できます。

分割終端でのSPLITの使用

SPLITピンの電圧出力は、通常モードで $0.5 \times V_{CC}$ となります。アプリケーションではこの回路を使用して、バスをCANネットワークの分割終端の中央タップに接続することにより、バスの同相モード電圧を安定化できます(図16および図3を参照)。このピンは、ネットワークの同相モード電圧を $0.5 \times V_{CC}$ から変化させる要因となる、非通電トランシーバのリーク電流や他のバイアス不均衡を相殺するための、安定化リセツブ電圧を提供します。CANネットワークでこの機能を利用すると、メッセージ送信の開始時にバス同相モード電圧レベルの変動を抑制することで、ネットワークの電磁放射特性を改善できます

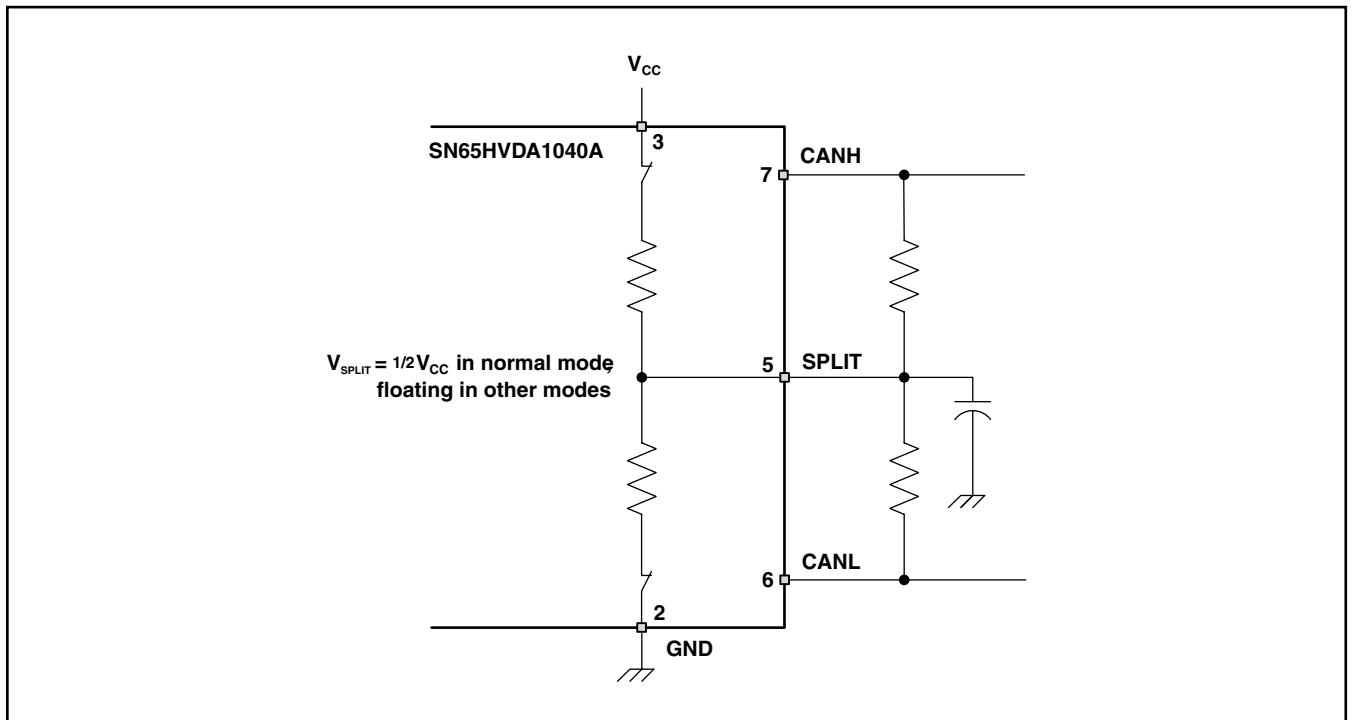


図 3. SPLITピンによる安定化回路およびアプリケーション

絶対最大定格 (1)(2)

1.1	V _{CC}	電源電圧範囲	-0.3V ~ 7V
1.2		バス端子の電圧範囲 (CANH, CANL, SPLIT)	-27V ~ 40V
1.3	I _O	レシーバ出力電流	20mA
1.4	V _I	電圧入力範囲、ISO 7637過渡パルス ⁽³⁾ (CANH, CANL)	-150V ~ 100V
1.5	V _I	電圧入力範囲 (TXD, STB)	-0.5V ~ 6V
1.6	T _J	接合部温度範囲	-40°C ~ 150°C

- (1) 絶対最大定格以上のストレスは、致命的なダメージを製品に与えることがあります。これはストレスの定格のみについて示してあり、このデータシートの「推奨動作条件」に示された値を越える状態での本製品の機能動作は含まれていません。絶対最大定格の状態に長時間置くと、本製品の信頼性に影響を与えることがあります。
- (2) 差動I/Oバス電圧を除くすべての電圧値は、回路のグランド端子を基準としています。
- (3) ISO 7637テスト・パルス1、2、3a、3bによりIBEEシステム・レベル・テストに従ってテスト済み (パルス1 = -100V、パルス2 = 100V、パルス3a = -150V、パルス3b = 100V)。AC過渡電圧にDCが結合される可能性がある場合は、すべてのバス端子で絶対最大電圧範囲以内にバス・ピンを外部保護してください。このデバイスは、コモンモード・チョーク使用時の+40VへのDCバス短絡をテスト済みです。システムでコモンモード・チョークが使用され、バス・ラインがDCに短絡される可能性がある場合には、チョークの種類と値、およびノードの終端と短絡電圧の組み合わせが、電圧最大仕様を超えた誘導性フライバックを生成しないことを確認するか、または外部の過渡抑制回路を使用してトランシーバを誘導性過渡電圧から保護してください。

静電放電保護

	パラメータ	測定条件	値	
2.1	静電気放電 ⁽¹⁾	人体モデル ⁽²⁾	CANHおよびCANL ⁽³⁾	±12 kV
2.2			SPLIT ⁽⁴⁾	±10 kV
2.3			すべてのピン	±4 kV
2.4		デバイス帯電モデル ⁽⁵⁾	すべてのピン	±1.5 kV
2.5		マシン・モデル ⁽⁶⁾		±200 V
2.6		IBEE CAN EMCテスト仕様に従った IEC 61400-4-2	CANHおよびCANLピンからGND	±7 kV

- (1) すべて+25°Cにおける標準値です。
- (2) JEDEC Standard 22 Test Method A114FおよびAEC-Q100-002に従ってテスト済みです。
- (3) テスト方法はJEDEC Standard 22 Test Method A114FおよびAEC-Q100-002に基づき、CANHおよびCANLバス・ピンは互いに、およびGNDに基づいてストレスを印加されます。
- (4) テスト方法はJEDEC Standard 22 Test Method A114FおよびAEC-Q100-002に基づき、SPLITピンはGNDに基づいてストレスを印加されます。
- (5) JEDEC Standard 22 Test Method C101DおよびAEC-Q100-011に従ってテスト済みです。
- (6) JEDEC Standard 22 Test Method A115FおよびAEC-Q100-003に従ってテスト済みです。

推奨動作条件

			MIN	MAX	単位	
3.1	V _{CC}	電源電圧	4.75	5.25	V	
3.2	V _I or V _{IC}	任意のバス端子の電圧 (個別または同相モード)	-12	12	V	
3.3	V _{IH}	“High” レベル入力電圧	TXD, STB	2	5.25	V
3.4	V _{IL}	“Low” レベル入力電圧	TXD, STB	0	0.8	V
3.5	V _{ID}	差動入力電圧		-6	6	V
3.6	I _{OH}	“H” レベル出力電流	ドライバ	-70	mA	
3.7			レシーバ (RXD)	-2		
3.8	I _{OL}	“L” レベル出力電流	ドライバ	70	mA	
3.9			レシーバ (RXD)	2		
3.10	T _A	動作フリーエア温度範囲	熱特性の表を参照	-40	125	°C

電気的特性

動作温度範囲を含む推奨動作条件範囲内（特に記述のない限り）

パラメータ		測定条件		MIN	TYP ⁽¹⁾	MAX	単位	
電源								
4.1	I _{CC} 5V電源電流	スタンバイ・モード	STBがV _{CC} 、V _I = V _{CC}	6	12		μA	
4.2		ドミナント	V _I = 0V、60Ω負荷、STBが0V	50	70		mA	
4.3		リセッシブ	V _I = V _{CC} 、無負荷、STBが0V	6	10			
4.4	UV _{VCC}	低電圧リセット・スレッシュヨルド		2.8		4.0	V	
デバイスのスイッチング特性								
5.1	t _{d(LOOP1)}	合計ループ遅延、ドライバ入力→レシーバ出力、リセッシブ→ドミナント	STBが0V、図11を参照	90		230	ns	
5.2	t _{d(LOOP2)}	合計ループ遅延、ドライバ入力→レシーバ出力、ドミナント→リセッシブ	STBが0V、図11を参照	90		230	ns	
ドライバ								
6.1	V _{O(D)}	バス出力電圧 (ドミナント)	CANH	V _I = 0V、STBが0V、R _L = 60Ω、 図4および図1を参照	2.9	3.4	4.5	V
6.2			CANL		0.8		1.75	
6.3	V _{O(R)}	バス出力電圧 (リセッシブ)		V _I = 3V、STBが0V、R _L = 60Ω、 図4および図1を参照	2	2.5	3	V
6.4	V _O	バス出力電圧 (スタンバイ・モード)		STBがV _{CC} 、R _L = 60Ω、 図4および図1を参照	-0.1		0.1	V
6.5	V _{OD(D)}	差動出力電圧 (ドミナント)		V _I = 0V、R _L = 60Ω、STBが0V、 図4、図1、および図5を参照	1.5		3	V
6.6				V _I = 0V、R _L = 45Ω、STBが0V、 図4、図1、および図5を参照	1.4		3	
6.7	V _{OD(R)}	差動出力電圧 (リセッシブ)		V _I = 3V、STBが0V、R _L = 60Ω、 図4および図1を参照	-0.012		0.012	V
6.8				V _I = 3V、STBが0V、無負荷	-0.5		0.05	
6.9	V _{SYM}	出力対称性 (ドミナントまたはリセッシブ) (V _{O(CANH)} + V _{O(CANL)})		STBが0V、R _L = 60Ω、図15を参照	0.9 V _{CC}	V _{CC}	1.1 V _{CC}	V
6.10	V _{OC(ss)}	定常状態の同相モード出力電圧		STBが0V、R _L = 60Ω、図10を参照	2	2.5	3	V
6.11	ΔV _{OC(ss)}	定常状態の同相モード出力電圧の変化量		STBが0V、R _L = 60Ω、図10を参照		30		mV
6.12	V _{IH}	“High” レベル入力電圧、TXD入力			2			V
6.13	V _{IL}	“Low” レベル入力電圧、TXD入力					0.8	V
6.14	I _{IH}	“High” レベル入力電流、TXD入力		V _I がV _{CC}	-2		2	μA
6.15	I _{IL}	“Low” レベル入力電流、TXD入力		V _I が0V	-50		-10	μA
6.16	I _{O(off)}	パワーオフTXD出力電流		V _{CC} が0V、TXDが5V			1	μA
6.17	I _{OS(ss)}	短絡時の定常状態出力電流、ドミナント		V _{CANH} = -12V、CANLオープン、 TXD = “Low”、図13を参照	-120	-85		mA
6.18				V _{CANH} = 12V、CANLオープン、 TXD = “Low”、図13を参照		0.4	1	
6.19				V _{CANL} = -12V、CANHオープン、 TXD = “Low”、図13を参照	-1	-0.6		
6.20				V _{CANL} = 12V、CANHオープン、 TXD = “Low”、図13を参照		75	120	
6.21				V _{CANH} = 0V、CANLオープン、 TXD = “Low”、図13を参照	-100	-75		
6.22				V _{CANL} = 32V、CANHオープン、 TXD = “Low”、図13を参照		75	125	
6.23	I _{OS(ss)}	短絡時の定常状態出力電流、リセッシブ		-20V ≤ V _{CANH} ≤ 32V、CANLオープン、 TXD = “High”、図13を参照	-10		10	mA
6.24				-20V ≤ V _{CANL} ≤ 32V、CANHオープン、 TXD = “High”、図13を参照	-10		10	
6.25	C _O	出力容量		レシーバ入力容量を参照				

(1) すべて+25°C、5V電源における標準値です。

電気的特性

動作温度範囲を含む推奨動作条件範囲内（特に記述のない限り）

	パラメータ		測定条件	MIN	TYP ⁽¹⁾	MAX	単位
ドライバのスイッチング特性							
7.1	t _{PLH}	伝播遅延時間、“Low” → “High” レベル出力	STBが0V、図6を参照	25	65	120	ns
7.2	t _{PHL}	伝播遅延時間、“High” → “Low” レベル出力	STBが0V、図6を参照	25	45	120	ns
7.3	t _r	差動出力信号立ち上がり時間	STBが0V、図6を参照		25		ns
7.4	t _f	差動出力信号立ち下がり時間	STBが0V、図6を参照		45		ns
7.5	t _{en}	スタンバイ・モードから通常モードおよびドミナント送信のイネーブル時間	図9を参照			10	μs
7.6	t _(dom)	ドミナント・タイムアウト ⁽²⁾	↓ V _I 、図12を参照	300	450	700	μs
レシーバ							
8.1	V _{IT+}	正方向の入カスレッシュヨルド電圧、高速モード	STBが0V、表4を参照		800	900	mV
8.2	V _{IT-}	負方向の入カスレッシュヨルド電圧、高速モード	STBが0V、表4を参照	500	650		mV
8.3	V _{hys}	ヒステリシス電圧 (V _{IT+} - V _{IT-})		100	125		mV
8.4	V _{IT}	入カスレッシュヨルド電圧、スタンバイ・モード	STBがV _{CC}	500		1150	mV
8.5	V _{OH}	“High” レベル出力電圧	I _O = -2mA、図8を参照	4	4.6		V
8.6	V _{OL}	“Low” レベル出力電圧	I _O = 2mA、図8を参照		0.2	0.4	V
8.7	I _{I(off)}	パワーオフ時バス入力電流 (非通電時バス・リーク電流)	CANH = CANL = 5V、V _{CC} が0V、TXDが0V			3	μA
8.8	I _{O(off)}	パワーオフ時RXDリーク電流	V _{CC} が0V、RXDが5V			20	μA
8.9	C _I	対グラウンド入力容量 (CANHまたはCANL)	TXDが3V、V _I = 0.4 sin(4E6πt)		13		pF
8.10	C _{ID}	差動入力容量	TXDが3V、V _I = 0.4 sin(4E6πt)		6		pF
8.11	R _{ID}	差動入力抵抗	TXDが3V、STBが0V	30		80	kΩ
8.12	R _{IN}	入力抵抗 (CANHまたはCANL)	TXDが3V、STBが0V	15	30	40	kΩ
8.13	R _{I(m)}	入力抵抗マッチング [1 - (R _{IN (CANH)} / R _{IN (CANL)})] × 100%	V _(CANH) = V _(CANL)	-3	0	3	%
レシーバのスイッチング特性							
9.1	t _{PLH}	伝播遅延時間、“Low” → “High” レベル出力	STBが0V、図8を参照	60	90	130	ns
9.2	t _{PHL}	伝播遅延時間、“High” → “Low” レベル出力	STBが0V、図8を参照	45	70	130	ns
9.3	t _r	出力信号立ち上がり時間	STBが0V、図8を参照		8		ns
9.4	t _f	出力信号立ち下がり時間	STBが0V、図8を参照		8		ns
9.5	t _{BUS}	スタンバイからのウェークアップに必要なバス上のドミナント時間	STBがV _{CC} 、図14を参照	1.5		5	μs
STBピン							
10.1	V _{IH}	“High” レベル入力電圧、STB入力		2			V
10.2	V _{IL}	“Low” レベル入力電圧、STB入力				0.8	V
10.3	I _{IH}	“High” レベル入力電流 STBがV _{CC}	STB at V _{CC}	-10		0	μA
10.4	I _{IL}	“Low” レベル入力電流 STBが0V	STB at 0 V	-10		0	μA
SPLITピン							
11.1	V _O	出力電圧	-500 μA < I _O < 500 μA	0.3 V _{CC}	0.5 V _{CC}	0.7 V _{CC}	V
11.2	I _{O(stb)}	リーク電流、スタンバイ・モード	STBが2V、-12V ≤ V _O ≤ 12V	55			μA

(2) TXDドミナント・タイムアウト (t_(dom)) は、TXDが t_(dom)より長い時間ドミナントになると、トランシーバのドライバがディスエーブルになり、バス・ラインがリセッブに解放されることで、ローカル障害発生時にバスがドミナントにロックされることを防止します。ドライバは、TXDが “High” (リセッブ)に戻った後でのみ、再びドミナントを送信できます。これによってバスがローカル障害によるドミナント・ロックから保護される一方、可能な最小データ・レートは制限されます。CANプロトコルでは、ワーストケースで最大11の連続したドミナント・ビット (TXD上) が許可されています。これは、5個の連続したドミナント・ビットの直後にエラー・フレームが続く場合です。これに加えて、t_(dom)の最小値によって、最小ビット・レートが制限されます。最小ビット・レートは次のように計算できます。

$$\text{最小ビット・レート} = 11/t_{(dom)} = 11 \text{ビット}/300\mu\text{s} = 37\text{kbps}$$

熱特性

推奨動作条件範囲内、 $T_A = -40^{\circ}\text{C} \sim 125^{\circ}\text{C}$ (特に記述のない限り)

	パラメータ	測定条件	MIN	TYP	MAX	単位
12.1	θ_{JA} 接合部-大気間熱抵抗 ⁽¹⁾	Low-K熱抵抗 ⁽²⁾		211		$^{\circ}\text{C}/\text{W}$
12.2		High-K熱抵抗 ⁽²⁾		131		
12.3	θ_{JB} 接合部-基板間熱抵抗			53		$^{\circ}\text{C}/\text{W}$
12.4	θ_{JC} 接合部-ケース間熱抵抗			79		$^{\circ}\text{C}/\text{W}$
12.5	P_D 平均消費電力	$V_{CC} = 5\text{V}$ 、 $T_J = 27^{\circ}\text{C}$ 、 $R_L = 60\Omega$ 、STBが0V、TXDに500kHz入力、デューティ・サイクル50%の方形波、RXDの $C_L = 15\text{pF}$		112		mW
12.6		$V_{CC} = 5.5\text{V}$ 、 $T_J = 130^{\circ}\text{C}$ 、 $R_L = 45\Omega$ 、STBが0V、TXDに500kHz入力、デューティ・サイクル50%の方形波、RXDの $C_L = 15\text{pF}$			170	
12.7	過熱シャットダウン温度			185		$^{\circ}\text{C}$

(1) 接合部温度(T_J)は、 $T_J = T_A + (P_D \times \theta_{JA})$ として計算されます。

(2) リード付き表面実装パッケージに対するLow-K(EIA/JESD51-3)またはHigh-K(EIA/JESD51-7)熱測定定義に従って測定しています。

パラメータ測定情報

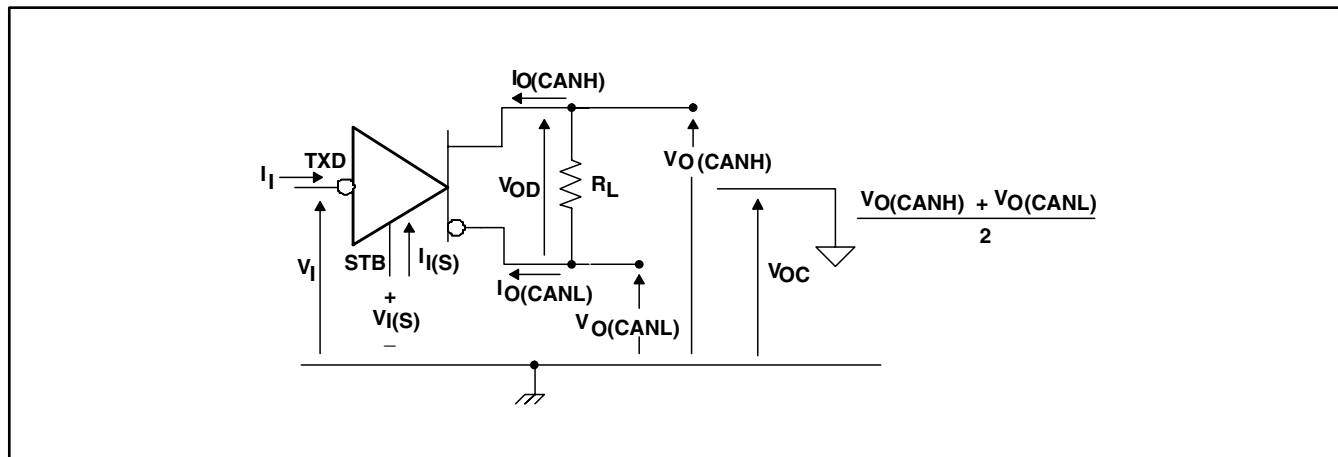


図 4. ドライバの電圧、電流、および測定定義

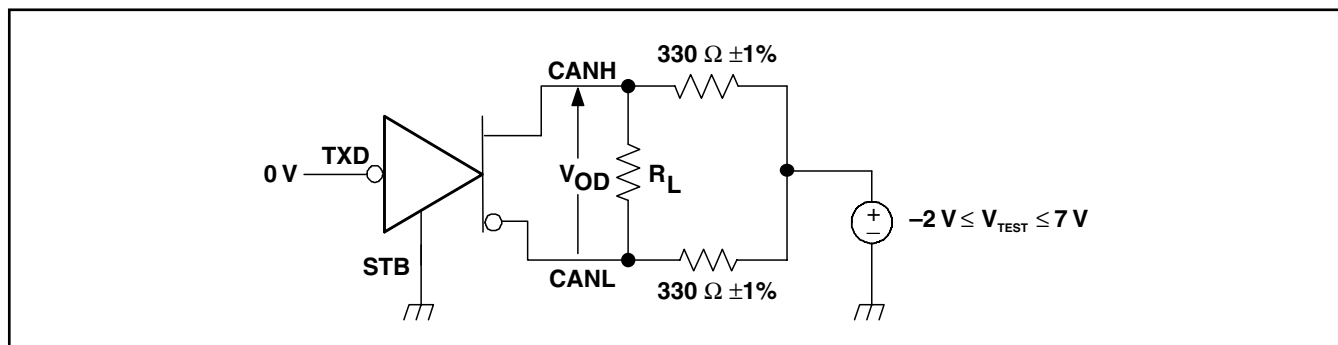


図 5. ドライバV_{OD}測定回路

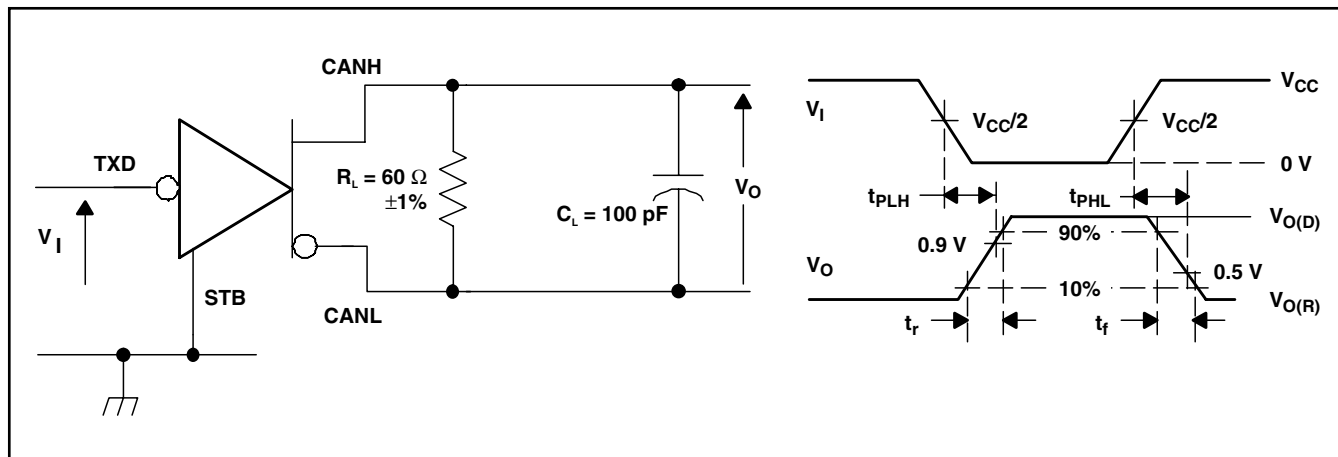


図 6. ドライバ測定回路と電圧波形

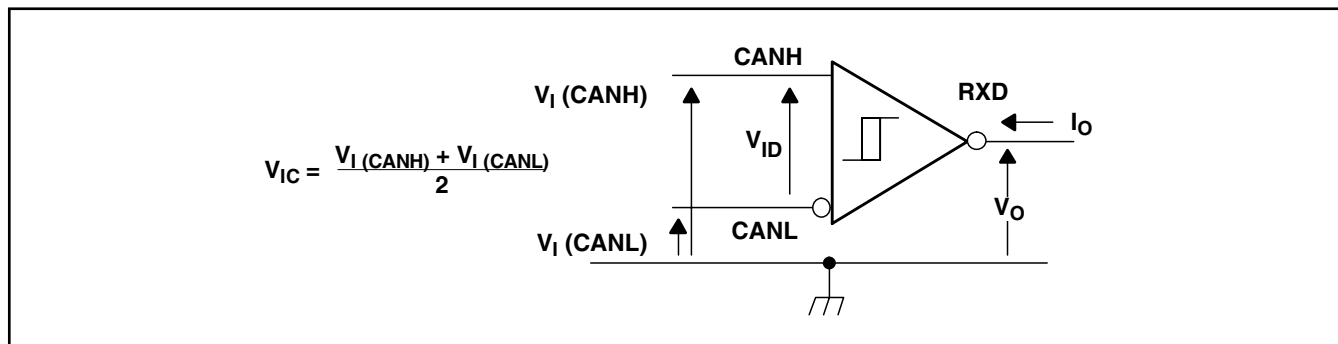


図 7. レシーバの電圧と電流定義

$$V_{IC} = \frac{V_I(CANH) + V_I(CANL)}{2}$$

パラメータ測定情報

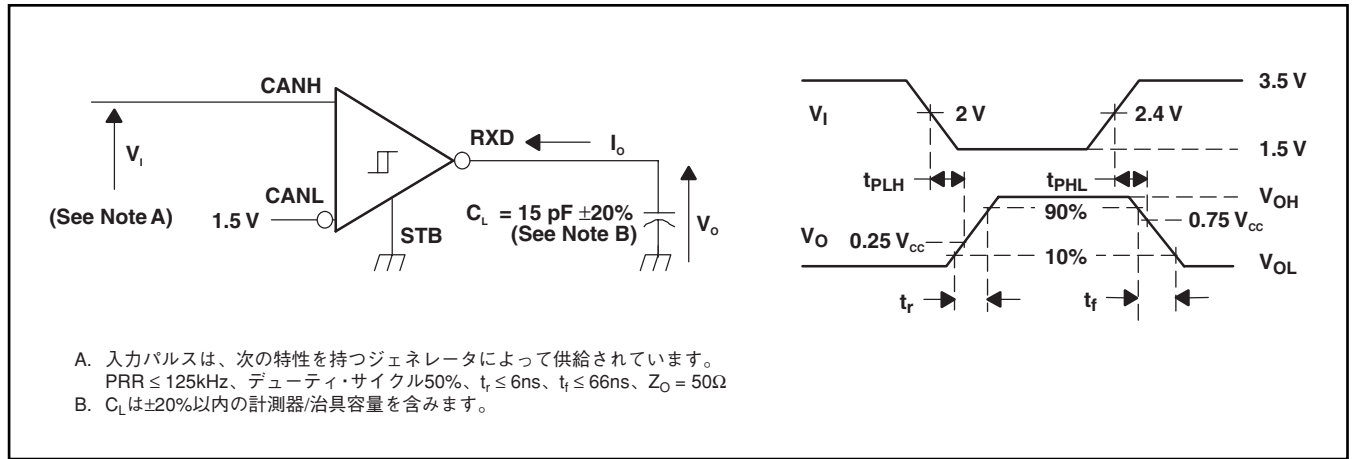


図 8. レシーバ測定回路と電圧波形

入力			出力	
V_{CANH}	V_{CANL}	$ V_{ID} $	R	
-11.1 V	-12 V	900 mV	L	V_{OL}
12 V	11.1 V	900 mV	L	
-6 V	-12 V	6 V	L	
12 V	6 V	6 V	L	
-11.5 V	-12 V	500 mV	H	V_{OH}
12 V	11.5 V	500 mV	H	
-12 V	-6 V	6 V	H	
6 V	12 V	6 V	H	
オープン	オープン	X	H	

表 4. 差動入力電圧スレッシュヨルド測定

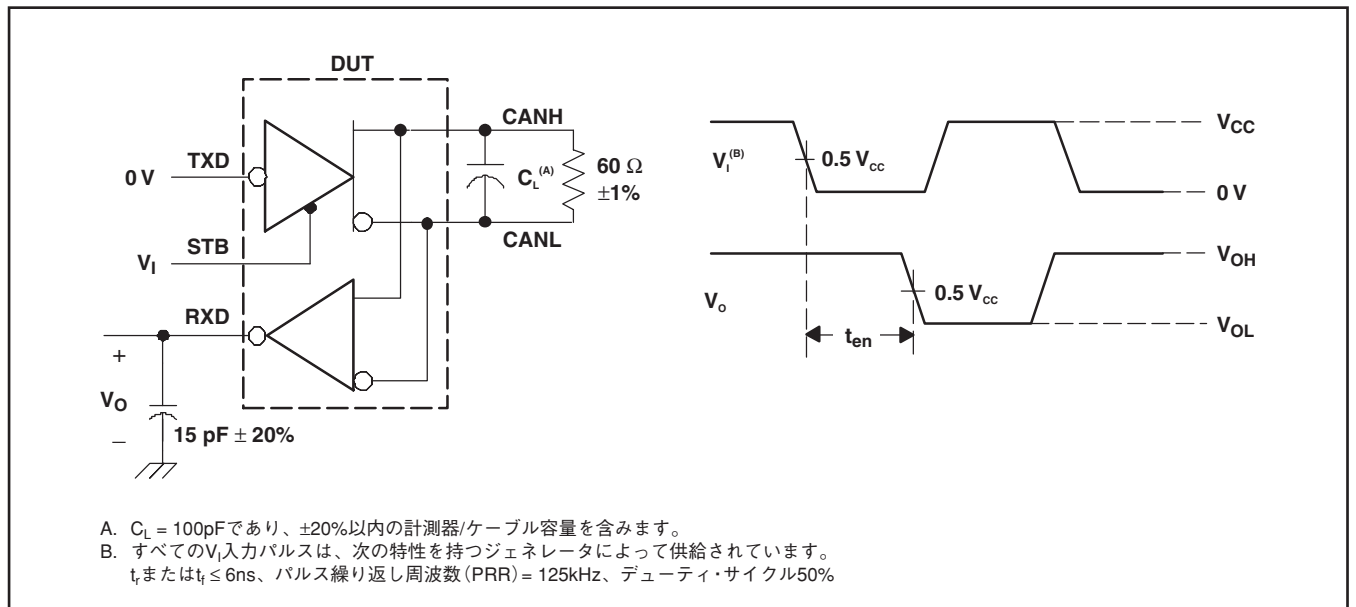
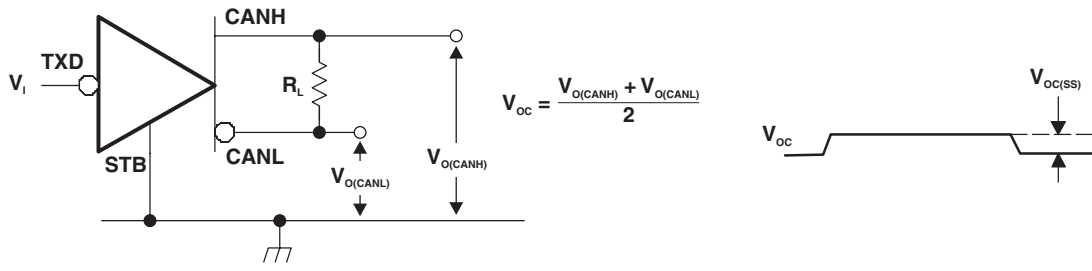
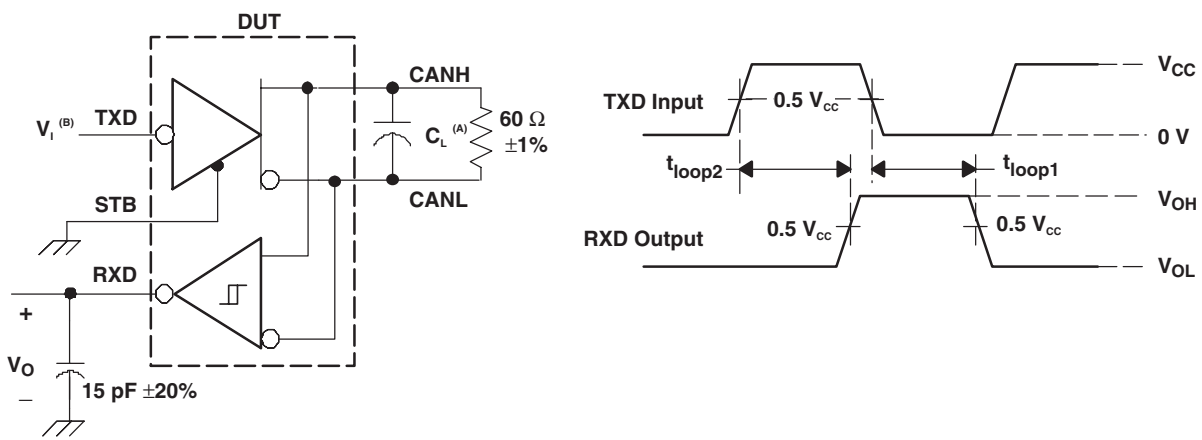


図 9. t_{en} 測定回路と波形



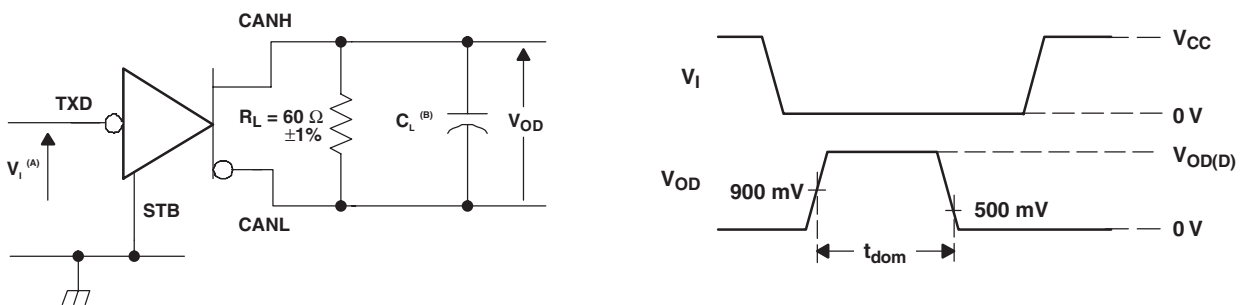
注：すべての V_I 入力パルスは $0V \sim V_{CC}$ であり、次の特性を持つジェネレータによって供給されています。
 t_r または $t_f \leq 6ns$ 、パルス繰り返し周波数 (PRR) = 125kHz、デューティ・サイクル50%

図 10. 同相モード出力電圧の測定回路と波形



A. $C_L = 100pF$ であり、 $\pm 20\%$ 以内の計測器/ケーブル容量を含みます。
 B. すべての V_I 入力パルスは $0V \sim V_{CC}$ であり、次の特性を持つジェネレータによって供給されています。
 t_r または $t_f \leq 6ns$ 、パルス繰り返し周波数 (PRR) = 125kHz、デューティ・サイクル50%

図 11. $t_{(LOOP)}$ 測定回路と波形



A. すべての V_I 入力パルスは $0V \sim V_{CC}$ であり、次の特性を持つジェネレータによって供給されています。
 t_r または $t_f \leq 6ns$ 、パルス繰り返し周波数 (PRR) = 500Hz、デューティ・サイクル50%
 B. $C_L = 100pF$ であり、 $\pm 20\%$ 以内の計測器/治具容量を含みます。

図 12. ドミナント・タイムアウト測定回路と波形

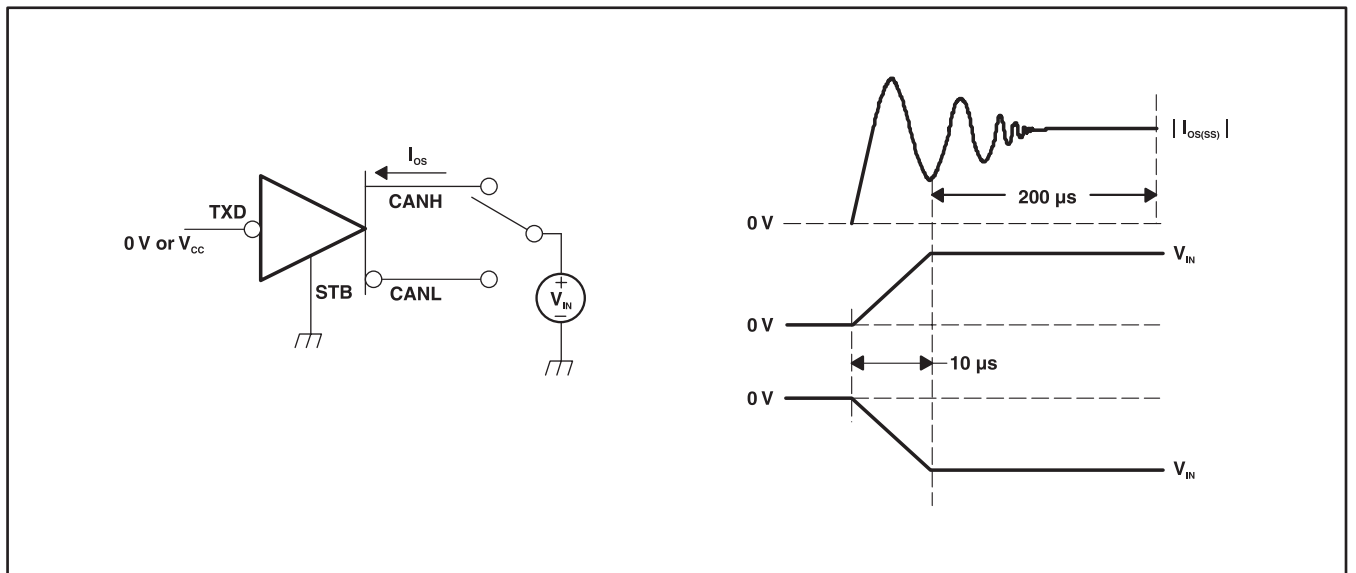


図 13. ドライバ短絡電流の測定回路と波形

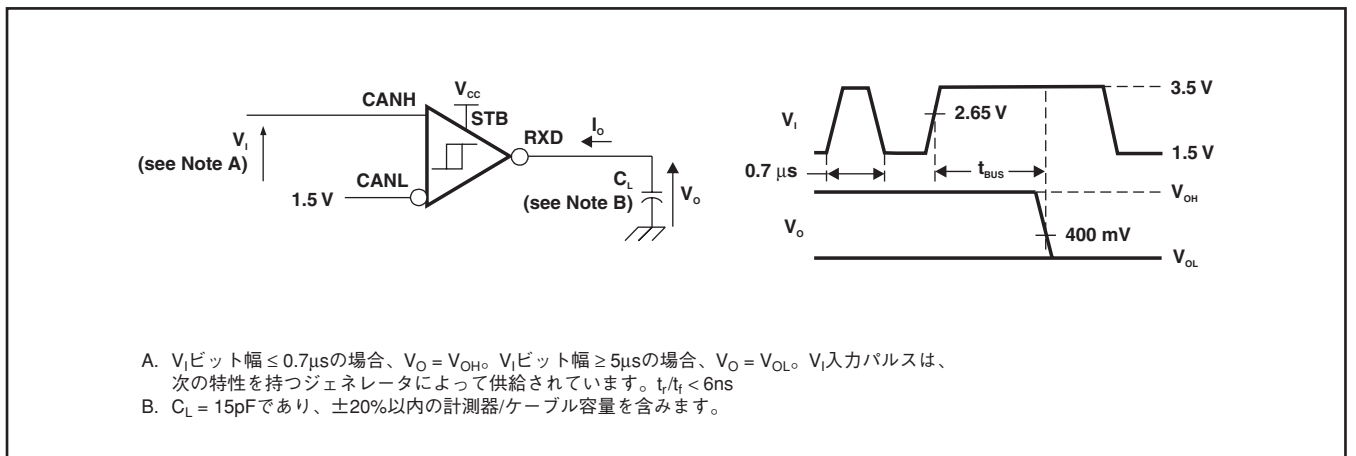


図 14. t_{BUS} 測定回路と波形

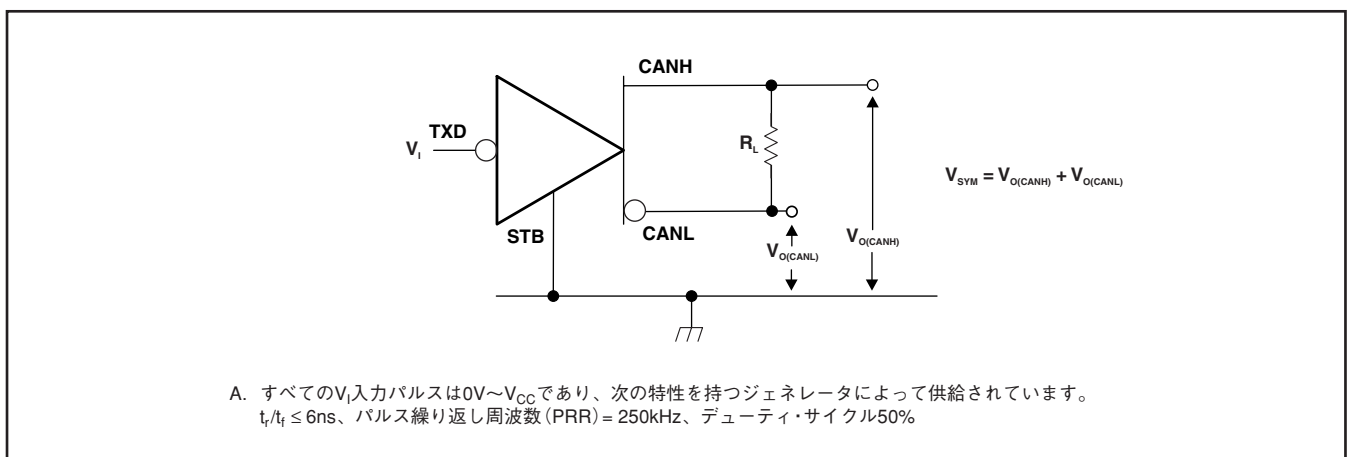
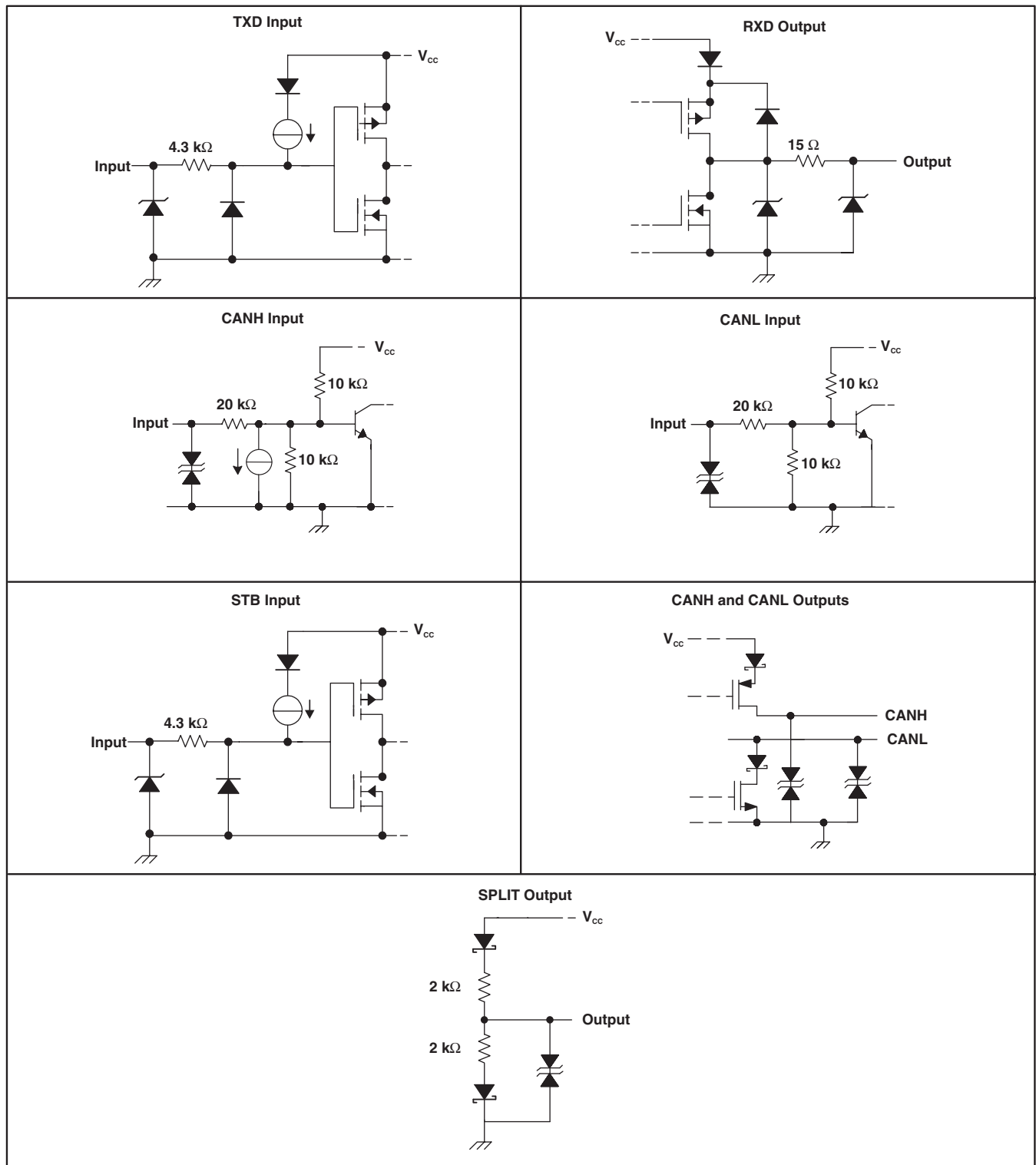


図 15. ドライバ出力対称性の測定回路

等価入出力回路図



アプリケーション情報

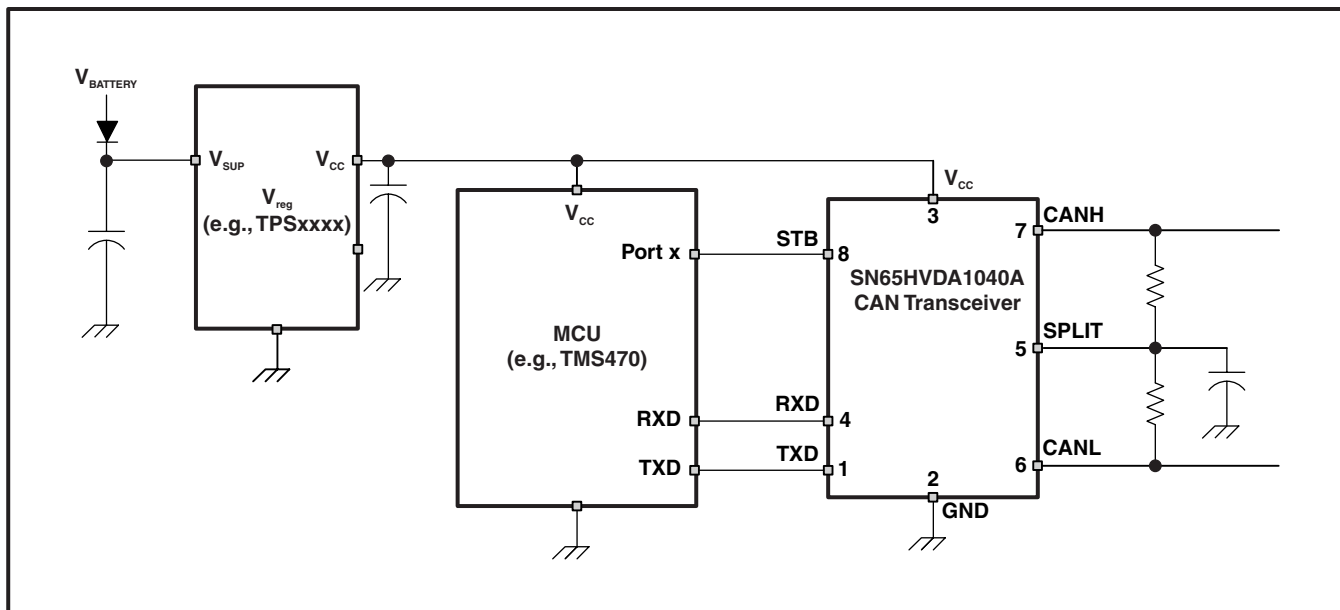


図 16. 安定化用の分割終端を使用した標準的アプリケーション

パッケージ・オプション

製品情報

Orderable Device	Status ⁽¹⁾	Package Type	Package Drawing	Pins	Package Qty	Eco Plan ⁽²⁾	Lead/Ball Finish	MSL Peak Temp ⁽³⁾
SN65HVD A1040AQDRQ1	ACTIVE	SOIC	D	8	2500	Green (RoHS & no Sb/Br)	CU NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM

(1) マーケティング・ステータスは次のように定義されています。

ACTIVE：製品デバイスが新規設計用に推奨されています。

LIFEBUY：TIによりデバイスの生産中止予定が発表され、ライフタイム購入期間が有効です。

NRND：新規設計用に推奨されていません。デバイスは既存の顧客をサポートするために生産されていますが、TIでは新規設計にこの部品を使用することを推奨していません。

PREVIEW：デバイスは発表済みですが、まだ生産が開始されていません。サンプルが提供される場合と、提供されない場合があります。

OBSOLETE：TIによりデバイスの生産が中止されました。

(2) エコ・プラン - 環境に配慮した製品分類プランであり、Pb-Free (RoHS)、Pb-Free (RoHS Expert) およびGreen (RoHS & no Sb/Br) があります。最新情報および製品内容の詳細については、<http://www.ti.com/productcontent>でご確認ください。

TBD：Pb-Free/Green変換プランが策定されていません。

Pb-Free (RoHS)：TIにおける“Lead-Free”または“Pb-Free”(鉛フリー)は、6つの物質すべてに対して現在のRoHS要件を満たしている半導体製品を意味します。これには、同種の材質内で鉛の重量が0.1%を超えないという要件も含まれます。高温で半田付けするように設計されている場合、TIの鉛フリー製品は指定された鉛フリー・プロセスでの使用に適しています。

Pb-Free (RoHS Exempt)：この部品は、1) ダイとパッケージの間に鉛ベースの半田バンプ使用、または 2) ダイとリードフレーム間に鉛ベースの接着剤を使用、が除外されています。それ以外は上記の様にPb-Free (RoHS)と考えられます。

Green (RoHS & no Sb/Br)：TIにおける“Green”は、“Pb-Free”(RoHS互換)に加えて、臭素 (Br) およびアンチモン (Sb) をベースとした難燃材を含まない(均質な材質中のBrまたはSb重量が0.1%を超えない)ことを意味しています。

(3) MSL、ピーク温度 -- JEDEC業界標準分類に従った耐湿性レベル、およびピーク半田温度です。

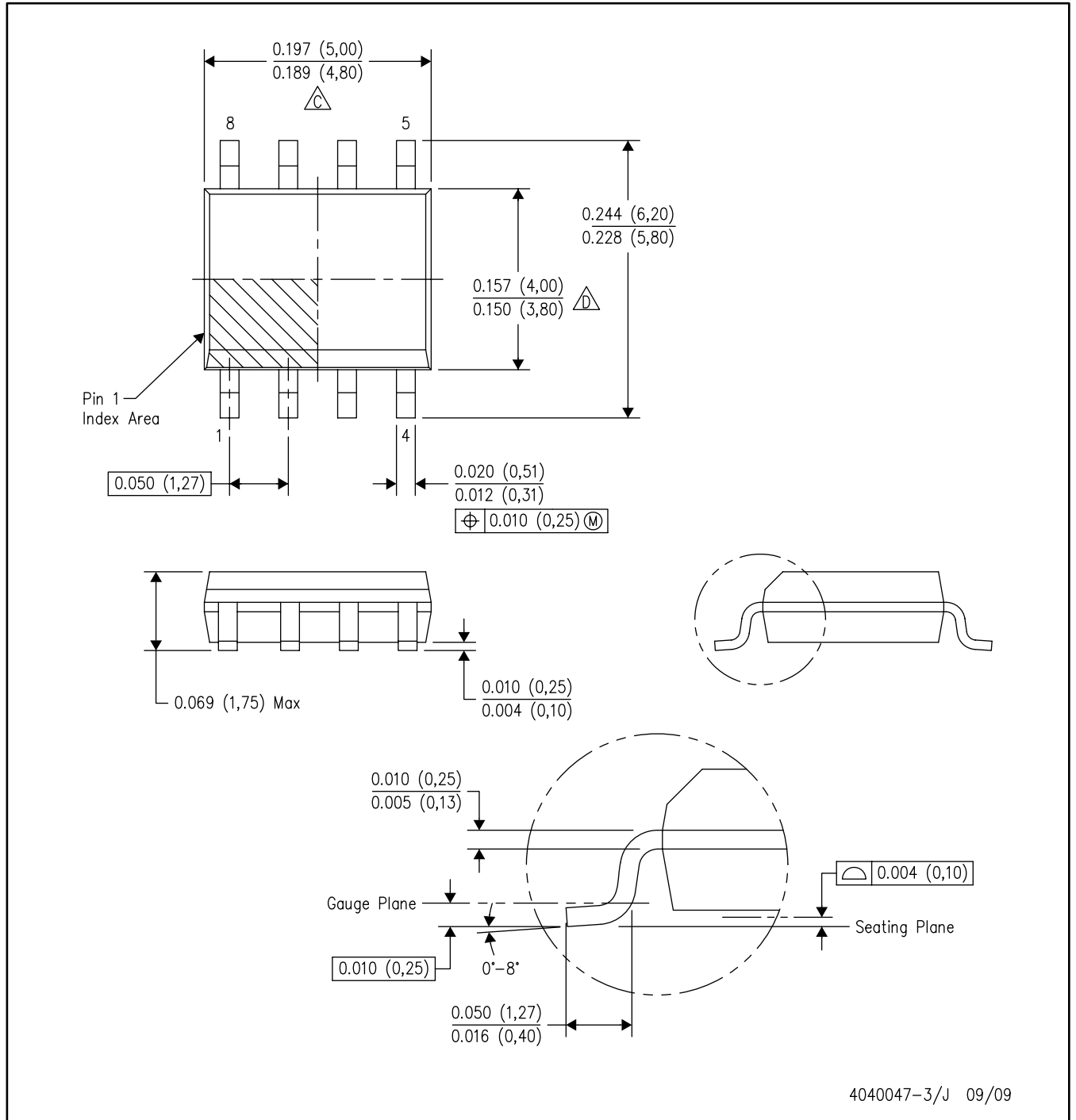
重要な情報および免責事項：このページに記載された情報は、記載された日付時点でのTIの知識および見解を表しています。TIの知識および見解は、第三者によって提供された情報に基づいており、そのような情報の正確性について何らの表明および保証も行いません。第三者からの情報をより良く統合するための努力は続けております。TIでは、事実を適切に表す正確な情報を提供すべく妥当な手順を踏み、引き続きそれを継続してゆきますが、受け入れる部材および化学物質に対して破壊試験や化学分析は実行していない場合があります。TIおよびTI製品の供給者は、特定の情報を機密情報として扱っているため、CAS番号やその他の制限された情報が公開されない場合があります。

TIは、いかなる場合においても、かかる情報により発生した損害について、TIがお客様に1年間に販売した本書記載の問題となった TIパーツの購入価格の合計金額を超える責任を負いかねます。

メカニカル・データ

D (R-PDSO-G8)

PLASTIC SMALL-OUTLINE PACKAGE



- 注： A. すべての直線寸法はインチ(mm)単位です。
 B. この図面は、予告なく変更される可能性があります。
 C. モールドの突起、突出部、ゲートのバリは、どの端でも 0.006 インチ (0.15mm) 以下とします。
 D. リード間の突起は、どの側でも 0.017 インチ (0.43mm) 以下とします。
 E. JEDEC MS-012 variation AA に準拠。

(SLLS995)

ご注意

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社(以下TIJといひます)及びTexas Instruments Incorporated(TIJの親会社、以下TIJないしTexas Instruments Incorporatedを総称してTIといひます)は、その製品及びサービスを任意に修正し、改善、改良、その他の変更をし、もしくは製品の製造中止またはサービスの提供を中止する権利を留保します。従いまして、お客様は、発注される前に、関連する最新の情報を取得して頂き、その情報が現在有効かつ完全なものであるかどうかをご確認下さい。全ての製品は、お客様とTIJとの間に取引契約が締結されている場合は、当該契約条件に基づき、また当該取引契約が締結されていない場合は、ご注文の受諾の際に提示されるTIJの標準販売契約約款に従って販売されます。

TIJは、そのハードウェア製品が、TIの標準保証条件に従い販売時の仕様に対応した性能を有していること、またはお客様とTIJとの間で合意された保証条件に従い合意された仕様に対応した性能を有していることを保証します。検査およびその他の品質管理技法は、TIが当該保証を支援するのに必要とみなす範囲で行なわれております。各デバイスの全てのパラメータに関する固有の検査は、政府がそれ等の実行を義務づけている場合を除き、必ずしも行なわれておりません。

TIJは、製品のアプリケーションに関する支援もしくはお客様の製品の設計について責任を負うことはありません。TI製部品を使用しているお客様の製品及びそのアプリケーションについての責任はお客様にあります。TI製部品を使用したお客様の製品及びアプリケーションについて想定される危険を最小のものとするため、適切な設計上および操作上の安全対策は、必ずお客様にてお取り下さい。

TIJは、TIの製品もしくはサービスが使用されている組み合わせ、機械装置、もしくは方法に関連しているTIの特許権、著作権、回路配置利用権、その他のTIの知的財産権に基づいて何らかのライセンスを許諾するということは明示的にも黙示的にも保証も表明もしていません。TIが第三者の製品もしくはサービスについて情報を提供することは、TIが当該製品もしくはサービスを使用することについてライセンスを与えるとか、保証もしくは承認をすることを意味しません。そのような情報を使用するには第三者の特許その他の知的財産権に基づき当該第三者からライセンスを得なければならない場合もあり、またTIの特許その他の知的財産権に基づきTIからライセンスを得て頂かなければならない場合もあります。

TIのデータ・ブックもしくはデータ・シートの中にある情報を複製することは、その情報に一切の変更を加えること無く、かつその情報と結び付けられた全ての保証、条件、制限及び通知と共に複製がなされる限りにおいて許されるものとします。当該情報に変更を加えて複製することは不正で誤認を生じさせる行為です。TIは、そのような変更された情報や複製については何の義務も責任も負いません。

TIの製品もしくはサービスについてTIJにより示された数値、特性、条件その他のパラメータと異なる、あるいは、それを超えてなされた説明で当該TI製品もしくはサービスを再販売することは、当該TI製品もしくはサービスに対する全ての明示的保証、及び何らかの黙示的保証を無効にし、かつ不正で誤認を生じさせる行為です。TIJは、そのような説明については何の義務も責任もありません。

TIJは、TIの製品が、安全でないことが致命的となる用途ないしアプリケーション(例えば、生命維持装置のように、TI製品に不良があった場合に、その不良により相当な確率で死傷等の重篤な事故が発生するようなもの)に使用されることを認めておりません。但し、お客様とTIの双方の権限有る役員が書面でそのような使用について明確に合意した場合は除きます。たとえTIJがアプリケーションに関連した情報やサポートを提供したとしても、お客様は、そのようなアプリケーションの安全面及び規制面から見た諸問題を解決するために必要とされる専門的知識及び技術を持ち、かつ、お客様の製品について、またTI製品をそのような安全でないことが致命的となる用途に使用することについて、お客様が全ての法的責任、規制を遵守する責任、及び安全に関する要求事項を満足させる責任を負っていることを認め、かつそのことに同意します。さらに、もし万一、TIの製品がそのような安全でないことが致命的となる用途に使用されたことによって損害が発生し、TIないしその代表者がその損害を賠償した場合は、お客様がTIないしその代表者にその全額の補償をするものとします。

TI製品は、軍事的用途もしくは宇宙航空アプリケーションないし軍事的環境、航空宇宙環境にて使用されるようには設計もされていませんし、使用されることを意図されていません。但し、当該TI製品が、軍需対応グレード品、若しくは「強化プラスチック」製品としてTIが特別に指定した製品である場合は除きます。TIが軍需対応グレード品として指定した製品のみが軍需品の仕様書に合致いたします。お客様は、TIが軍需対応グレード品として指定していない製品を、軍事的用途もしくは軍事的環境下で使用することは、もっぱらお客様の危険負担においてなされるということ、及び、お客様がもっぱら責任をもって、そのような使用に関して必要とされる全ての法的要求事項及び規制上の要求事項を満足させなければならないことを認め、かつ同意します。

TI製品は、自動車用アプリケーションないし自動車の環境において使用されるようには設計されていませんし、また使用されることを意図されていません。但し、TIがISO/TS 16949の要求事項を満たしていると特別に指定したTI製品は除きます。お客様は、お客様が当該TI指定品以外のTI製品を自動車用アプリケーションに使用しても、TIは当該要求事項を満たしていなかったことについて、いかなる責任も負わないことを認め、かつ同意します。

Copyright © 2009, Texas Instruments Incorporated
日本語版 日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

弊社半導体製品の取り扱い・保管について

半導体製品は、取り扱い、保管・輸送環境、基板実装条件によっては、お客様での実装前後に破壊/劣化、または故障を起こすことがあります。

弊社半導体製品のお取り扱い、ご使用にあたっては下記の点を遵守して下さい。

1. 静電気

素手で半導体製品単体を触らないこと。どうしても触る必要がある場合は、リストストラップ等で人体からアースをとり、導電性手袋等をして取り扱うこと。

弊社出荷梱包単位(外装から取り出された内装及び個装)又は製品単品で取り扱いを行う場合は、接地された導電性のテーブル上で(導電性マットにアースをとったもの等)、アースをした作業者が行うこと。また、コンテナ等も、導電性のものを使うこと。

マウンタやはんだ付け設備等、半導体の実装に関わる全ての装置類は、静電気の帯電を防止する措置を施すこと。

前記のリストストラップ・導電性手袋・テーブル表面及び実装装置類の接地等の静電気帯電防止措置は、常に管理されその機能が確認されていること。

2. 温・湿度環境

温度: 0 ~ 40 °C、相対湿度: 40 ~ 85%で保管・輸送及び取り扱いを行うこと。(但し、結露しないこと。)

直射日光があたる状態で保管・輸送しないこと。

3. 防湿梱包

防湿梱包品は、開封後は個別推奨保管環境及び期間に従い基板実装すること。

4. 機械的衝撃

梱包品(外装、内装、個装)及び製品単品を落下させたり、衝撃を与えないこと。

5. 熱衝撃

はんだ付け時は、最低限260 °C以上の高温状態に、10秒以上さらさないこと。(個別推奨条件がある時はそれに従うこと。)

6. 汚染

はんだ付け性を損なう、又はアルミ配線腐食の原因となるような汚染物質(硫黄、塩素等ハロゲン)のある環境で保管・輸送しないこと。はんだ付け後は十分にフラックスの洗浄を行うこと。(不純物含有率が一定以下に保証された無洗浄タイプのフラックスは除く。)

以上